



会社名 **株式会社 サムコインターナショナル研究所** 登録銘柄 (店頭登録銘柄)  
 コード番号 6387 本社所在都道府県 京都府  
 本社所在地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長兼経理部長  
 氏名 山田史郎 TEL(075)621-7841  
 中間決算取締役会開催日 平成 14 年 3 月 25 日 中間配当制度の有無 有  
 中間配当支払日 平成 年 月 日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

## 1. 14 年 1 月中間期の業績(平成 13 年 8 月 1 日 ~ 平成 14 年 1 月 31 日)

(1) 経営成績 (注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
14 年 1 月中間期	1,839 ( 4.2)	374 ( 17.7)	368 ( 18.2)
13 年 1 月中間期	1,766 ( 23.1)	454 ( 61.3)	450 ( 65.7)
13 年 7 月期	4,078	902	907

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当 たり中間(当期)純利益
	百万円 %	円 銭	円 銭
14 年 1 月中間期	191 ( 24.9)	39 14	
13 年 1 月中間期	254 ( 62.6)	62 27	
13 年 7 月期	471	111 63	

(注) 持分法投資損益 14 年 1 月中間期 - 百万円 13 年 1 月中間期 百万円 13 年 7 月期 百万円  
 期中平均株式数 14 年 1 月中間期 4,889,680 株 13 年 1 月中間期 4,090,890 株 13 年 7 月期 4,226,780 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率  
 平成 14 年 1 月中間期の期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式控除後のものです。

## (2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
14 年 1 月中間期	0 00	-
13 年 1 月中間期	0 00	-
13 年 7 月期	-	12 50

## (3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
14 年 1 月中間期	7,126	4,541	63.7	928 88
13 年 1 月中間期	4,704	1,873	39.8	457 96
13 年 7 月期	7,574	4,419	58.3	903 62

(注) 期末発行済株式数 14 年 1 月中間期 4,889,140 株 13 年 1 月中間期 4,090,890 株 13 年 7 月期 4,890,890 株  
 期末自己株式数 14 年 1 月中間期 1,750 株 13 年 1 月中間期 - 株 13 年 7 月期 670 株

## (4) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
14 年 1 月中間期	150	128	457	1,243
13 年 1 月中間期	124	265	130	880
13 年 7 月期	441	2,502	2,881	1,717

## 2. 14 年 7 月期の業績予想 (平成 13 年 8 月 1 日 ~ 平成 14 年 7 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	3,050	400	243	12 50	12 50

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 49 円 70 銭

## 添付書類

### 1. 企業集団の状況

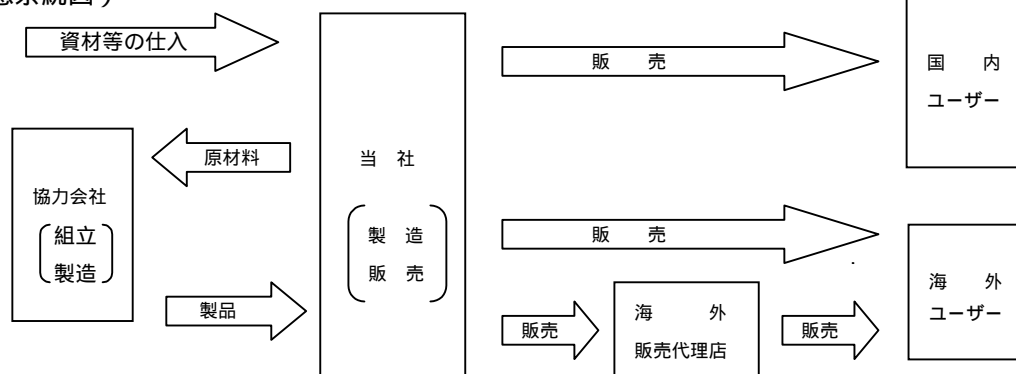
当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置のメーカーで、薄膜形成・加工装置の研究開発から製造販売までを事業としております。薄膜形成・加工の方法には CVD法 (Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法) PVD法 (Physical Vapor Deposition = 物理的気相成長法) に大別されますが、当社は による方法が中心で、特にプラズマ利用を得意としております。プラズマCVD装置では、10nm ~ 100µmまでの成膜が可能であります。(nm = ナノメートル : 10億分の1メートル µm = マイクロメートル : 百万分の1メートル)

当社の装置は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を切削加工するエッチング装置、基盤表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品完成後、独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行くと共に、海外については主に現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。

(業態系統図)



当社は装置を以下の通りに区分しております。

#### (CVD装置)

反応性の気体を基盤の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置 (LS = Liquid Source) に特徴があり、比較的低温反応で速度が速く、均一性のある成膜が可能であります。

#### (エッチング装置)

各種半導体の膜をはじめ微細加工が必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて切削していくものです。当社はICP (Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ) を利用したエッチングに特徴があり、高速でかつ均一性の優れた加工技術が可能であります。

#### (洗浄装置)

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求される3次元実装などに必要とされております。

#### (その他装置)

高速熱処理装置など、上記装置には含まれない特注品であります。

#### (その他)

部品、保守メンテナンスなどであります。

## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社は『薄膜技術で世界の産業科学に貢献する』ことを経営理念とし、

社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。

直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。

事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

### (2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けており、経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

### (3) 中期的な会社の経営戦略

当社は、光エレクトロニクス分野に特化した経営戦略で、業容を拡大してまいりました。同分野は、次世代通信網として期待されている光通信(ブロードバンド)に不可欠な光導波路、液晶パネルなどに利用されているLED(Light Emitting Diode=発光ダイオード)、技術開発が盛んに行われている有機EL(Electro Luminescence)や次世代光部品として有望なフォトニック結晶、面発光レーザーなど、その用途は多岐にわたり、中長期的には一層の成長が見込まれる分野であります。

当社といたしましては、引き続き光エレクトロニクス分野に経営資源を集中し、日米欧3極のグローバルな研究開発体制の下、新プロセス・新素材開発段階での高い技術開発力に基づく付加価値の高い製品づくりに一層邁進し、多様化・高度化するお客様のニーズに迅速かつ的確に対応できるソリューション提供企業として活動してまいります。

### (4) 対処すべき課題

半導体等電子部品製造装置業界におきましては、米国景気の遅れが背景にある中で、当社が特化しております光エレクトロニクス分野には明るさの兆しが見えるものの、回復のスピードの点で懸念されております。

このような環境下において、当社は、継続して研究開発に重点を置きつつ、量産用装置への本格展開に対する体制構築(新生産技術研究棟の立上げを含む)、拡大する中国市場への販売強化、国内販売網の拡充、及びコストダウンの定着などを直面する課題として取り組んでまいります。

### 3. 経営成績

#### (1) 当中間期の概況

当中間期のわが国経済は個人消費の低迷、民間設備投資の抑制など、全般的にデフレの様相を呈しつつ厳しい状況で推移し、景気の先行きに対する警戒感は一段と強まってまいりました。一方、米国経済に個人消費を中心に立ち直りの兆しが見えるものの、世界経済に与える影響は依然として弱く、回復の出口を懸命に探る展開となっております。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界も、世界的なIT(情報技術)不況の下、前年度の好調さから一転して、軒並み業績不振、設備投資抑制などが相次いで発表され、事業環境が悪化した状態となっております。

こうした環境の中ではありますが、当社はグローバルな研究体制の下、光エレクトロニクス分野を中心として積極的な研究開発活動と営業活動を展開し、またSCR15(Samco Cost Reduction 15)にて製品原価の15%低減に鋭意努力してまいりました。加えて産官学連携を主体に研究開発投資意欲が衰えなかったこと、また企業向け量産機を中心とした前期末受注残などにも支えられ、当中間期の業績はほぼ当初の見込み通りの結果になりました。

売上高は、前期の決算発表時の予想1,800百万円に対し1,839百万円、経常利益は、同258百万円に対し368百万円と、いずれも目標を上回る成果となっております。なお主な品目別の売上高は次の通りであります。

#### (CVD装置)

前期に受注した企業向け量産機としての光導波路用成膜装置が貢献したほか、今期に入り大学・官庁向けの研究開発用装置が堅調に推移しました。この結果、売上高は819百万円(前年同期比62.9%増)となりました。

#### (エッチング装置)

当社の規格品であるRIE-10NRやRIE-200iPなどが、企業・大学問わず研究開発用として底堅く推移したものの、企業向けはRIE-200LCなどの量産機がLED用として少数にとどまりました。この結果、売上高は688百万円(前年同期比18.9%減)となりました。

#### (洗浄装置)

米国向けのUV1が好調だったものの、国内向けの後工程用需要が低迷しました。この結果、売上高は126百万円(前年同期比51.3%減)と大幅ダウンとなりました。

#### (その他装置)

高速熱処理装置などの特殊な装置が貢献し、売上高48百万円(前年同期比103.4%増)となりました。

#### (その他)

部品やメンテナンスが安定的に底堅く推移し、売上高158百万円(前年同期比19.2%増)となりました。

#### (品目別売上高)

品目	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
CVD装置	819,042	44.5	162.9
エッチング装置	688,073	37.4	81.1
洗浄装置	126,211	6.9	48.7
その他装置	48,200	2.6	203.4
その他	158,271	8.6	119.2
合計	1,839,797	100.0	104.2

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、LED・半導体レーザー・DWDM(Dense Wavelength Division Multiplex=高密度波長多重伝送)関連の光エレクトロニクス分野(光エレクトロニクス分野) 各種センサー・水晶デバイス、高周波デバイスなどの電子部 phận、半導体パッケージ技術や混載技術などの実装・表面処理分野、有機EL、磁気ヘッドなどの表示・磁気記録分野、部品・メンテナンス、その他分野に分類しております。用途別売上構成は次の通りであります。

(用途別売上高)

用 途	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	977,032	53.1	127.8
電子部品分野	438,980	23.9	103.2
実装・表面処理分野	62,840	3.4	33.0
表示・磁気記録分野	48,979	2.7	38.4
部品・メンテナンス	158,271	8.6	119.2
その他分野	153,695	8.3	122.5
合 計	1,839,797	100.0	104.2

(2) 通期の見通し

当社の注力している光エレクトロニクス分野の研究開発用装置においては、大学・官庁関係向けに期待が持て、加えて台湾や中国市場からの引き合いも増加しているものの、依然として半導体等電子部品メーカーの設備投資削減や凍結が続いていること、また先行きの需要回復に不透明感が強いことから、下半期の業績への影響は避けられないと予想されます。当社としても期初より取組んでおりますSCR15のコスト低減効果が奏効してくるものの、当初の通期業績計画達成は厳しい状況にあり、売上高3,050百万円(前年同期比25.2%減) 経常利益400百万円(前年同期比55.9%減) 当期純利益243百万円(前年同期比48.5%減)となる見込みであります。